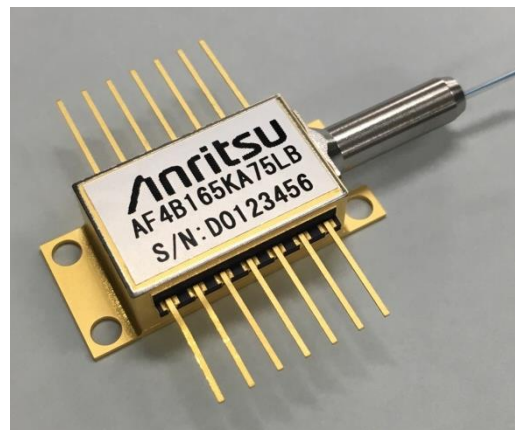


1.48 μ m LDモジュール AF4Bシリーズ type E

AF4B SERIES type Eは、エルビウムドープファイバアンプ励起用光源として開発された1.48 μ m帯高出力・低消費電力FP-LDモジュールです。

特長

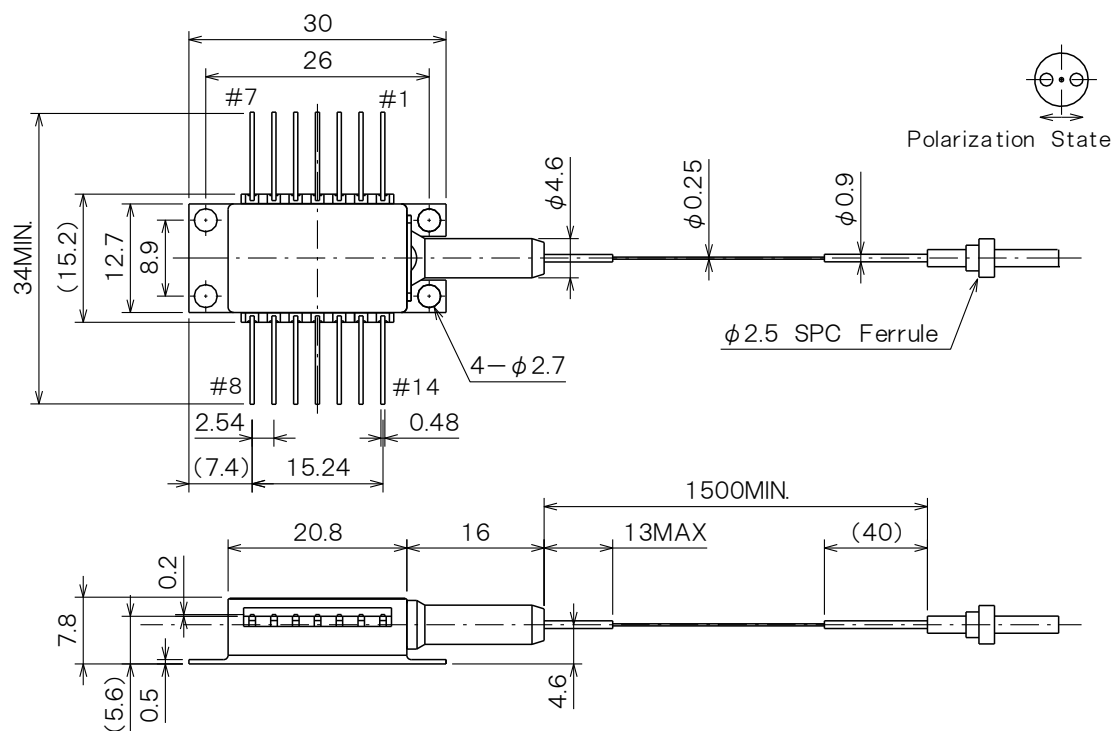
- ・ 光出力 AF4B155KA/KD75LB: 550mW
AF4B160KA/KD75LB: 600mW
AF4B165KA/KD75LB: 650mW
- ・ ファイバタイプ (ϕ 0.25mm UVコート)
シングルモードファイバ (SMF) / 偏波保持ファイバ (PMF)
- ・ 14ピンバタフライパッケージ
- ・ 光アイソレータ、モニタPDおよびクーラ内蔵
- ・ LD動作温度 35 $^{\circ}$ C



用途

- ・ EDFA励起用

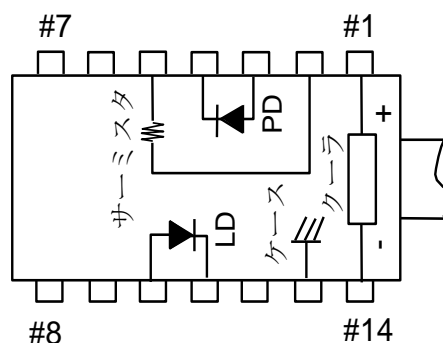
外形寸法 (単位: mm)



(注) 偏波保持ファイバ仕様LDの偏波方向は、PMFのスロー軸に対して平行です。

端子接続

No.	FUNCTION	No.	FUNCTION
1	クーラアノード	8	NC
2	サーミスタ	9	NC
3	PDアノード	10	LDアノード
4	PDカソード	11	LDカソード
5	サーミスタ	12	NC
6	NC	13	ケース
7	NC	14	クーラカソード



Top View

絶対最大定格

項目	記号	定格	単位
LD 順電流	I_F	2800	mA
LD 逆電圧	V_R	2	V
PD 順電流	I_{FD}	10	mA
PD 逆電圧	V_{RD}	20	V
動作ケース温度	T_C	-5 to +70	°C
保存温度	T_{stg}	-40 to +85	°C
クーラ電流	I_C	5.8	A

* 絶対最大定格を超えると故障の原因になることがあります。

電氣的・光学的特性 ($T_{LD}=35^{\circ}\text{C}$, $T_C=25^{\circ}\text{C}$)

項目	記号	測定条件	Min.	Typ.	Max.	単位
しきい値電流	I_{th}	-	-	-	250	mA
中心波長	λ_c	定格光出力時, RMS (-20dB)	1460	1475	1490	nm
スペクトル幅	$\Delta\lambda$	定格光出力時 -20dB	-	5	10	nm
モニタ電流	I_m	定格光出力時	300	-	3000	μA
PD 暗電流	I_d	$V_{RD}=5\text{V}$	-	-	0.1	μA
トラッキングエラー	ΔP_f	$I_m=\text{const.}, T_C=-5\sim 70^{\circ}\text{C}$	-	-	0.5	dB
アイソレーション	R_o	$T_{LD}=35^{\circ}\text{C}$	-	30	-	dB
偏波消光比 ^{*1}	X_p	定格光出力時	17	-	-	dB
サーミスタ抵抗	R_{th}	$T_{LD}=35^{\circ}\text{C}$	-	6.5	-	k Ω
		$T_{LD}=25^{\circ}\text{C}$	-	10.0	-	

(注) ^{*1}: PMF品に適用されます。

光出力 / クーラ特性 / 消費電力

項目	記号	測定条件	定格光出力			単位
			550mW	600mW	650mW	
順電流	I_F	定格光出力時、BOL	1980	2170	2440	mA
順電圧	V_F	定格光出力時、BOL	2.0	2.05	2.15	V
		定格光出力時、EOL*	2.24	2.3	2.41	V
クーラ電流	I_C	$I_F=*EOL, T_C=70^{\circ}\text{C}$	2.3	2.6	2.9	A
クーラ電圧	V_C	$I_F=*EOL, T_C=70^{\circ}\text{C}$	2.85	3.15	3.45	V

*: EOL(End of life)=BOL (Begin of life) $\times 1.12$

オーダーリングインフォメーション

形名 : A F 4 B 1 □ □ K □ □ □ □ B

◆中心波長精度 L : ±15nm K : ±10nm
◆中心波長 75 : 1475nm 80 : 1480nm 70 : 1470nm 65 : 1465nm
◆ファイバ種, コネクタ形状 A : SMF フェルル D : PMF フェルル G : SMF FC/PC K : PMF FC/PC
◆光出力 55 : 550mW 60 : 600mW 65 : 650mW



CAUTION : Handle the fiber of the enclosed device(s) with extreme care ; glass fiber is subject to breakage if mishandled and permanent damage to the device may result. Do not pull the device by the fiber or protective sleeve. Do not coil the fiber into a loop of than 30 mm in radius.

SEMICONDUCTOR LASER

DANGER

INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO
DIRECT OR SCATTERED RADIATION

AVOID EXPOSURE
Invisible laser radiation is emitted
from this aperture

OUTPUT POWER : 800mW
WAVELENGTH 0.80 to 1.80 μm
CLASS IV LASER PRODUCT

Caution - use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
This Product Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
Manufactured Anritsu Corp. 5-1-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa, Japan

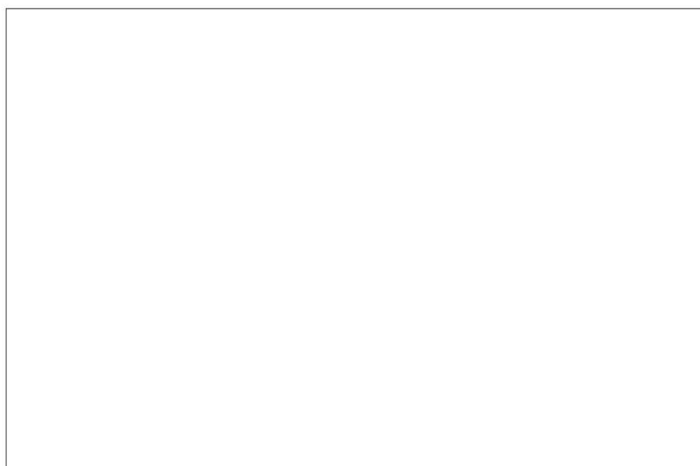
アンリツ株式会社

アンリツ株式会社
センシング&デバイスカンパニー 国内営業部

〒243-8555 神奈川県厚木市恩名5-1-1
TEL 046-296-6783 FAX 046-225-8390

URL: <https://www.anritsu.com/sensing-devices>

ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。